

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
höherer Sperrspannungen für allgemeine
Anwendungen

Bauform 3 E-Line

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,5 \text{ K/mW}$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SS 200	SS 201	SS 202
U_{CBO}, U_{CEV} (bei $-U_{BE} = 1 \text{ V}$)	70 V	100 V	120 V
U_{EBO}		5 V	
I_C		30 mA	
I_B		10 mA	
P_{tot} (bei $\vartheta_a \leq 25 \text{ °C}$)		150 mW	
ϑ_j		100 °C	
ϑ_a		-40 ... +85 °C	

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25 \text{ °C} - 5 \text{ K}$)

I_{CEV} (bei $U_{CE} = U_{CEV}, -U_{BE} = 1 \text{ V}$)	VIIIIIIIIII	1 μA
I_{EBO} (bei $U_{EB} = 5 \text{ V}$)	VIIIIIIIIII	100 nA
U_{CEsat} (bei $I_C = 1 \text{ mA}, I_B = 31 \mu\text{A}$)	VIIIIIIIIII	0,6 V
h_{21E} (bei $U_{CE} = 3 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}$)	VIIIIIIIIII	32